

1. m_A દળવાળો કણ A, v જેટલા વેગથી ગતિ કરતી વખતે તેના સુરેખ માર્ગમાં આવતા સ્થિર પડેલા m_B દળવાળા બીજા કણ B સાથે એક પરિમાણમાં સ્થિતિસ્થાપક સંઘાત અનુભવે તો કણ A ની ડી-બ્રોગ્લી તરંગલંબાઈમાં થતો ફેરફાર શોધો.

► કણ A માટે સંઘાત પહેલાં પ્રારંભિક ડી-બ્રોગ્લી તરંગલંબાઈ,

$$\lambda_i = \frac{h}{m_A v_i} = \frac{h}{m_A v} \quad (\because v_i = v) \quad \dots (1)$$

► હવે કણ A નો અંતિમ વેગ સૂત્રાનુસાર,

$$v_f = \left(\frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} \right) v_i = \left(\frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} \right) v \quad (\because v_i = v) \quad \dots (2)$$

⇒ કણ A ની અંતિમ ડી-બ્રોગ્લી તરંગલંબાઈ,

$$\lambda_f = \frac{h}{m_A v_f} = \frac{h}{m_A} \times \frac{(m_A + m_B)}{(m_A - m_B)v} \quad \dots (3)$$

► સમીકરણ (1) અને (3) પરથી, માંગેલો ફેરફાર,

$$\begin{aligned} \lambda_f - \lambda_i &= \frac{h}{m_A v} \left(\frac{m_A + m_B}{m_A - m_B} - 1 \right) \\ &= \frac{h}{m_A v} \left(\frac{m_A + m_B - m_A + m_B}{m_A - m_B} \right) \\ &= \frac{2hm_B}{m_A(m_A - m_B)v} \end{aligned}$$

2. 0.97 kg/m^3 ઘનતા ધરાવતા $(10^{-2} \text{ m})^2$ ક્ષેત્રફળવાળા તથા 10^{-3} m જડાઈવાળા સોડિયમના સ્તર પર 660 nm તરંગલંબાઈવાળો 100 W/m^2 તીવ્રતાવાળો પ્રકાશ આપાત કરતા સમગ્ર સ્તરમાંથી ઉત્સર્જતા ઇલેક્ટ્રોન્સને કારણે $100 \mu\text{A}$ જેટલો ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ રચાય છે. હવે જો સોડિયમનો એક પરમાણુ, એક ફોટોનનું શોષણ કરે તો તેમાંથી ફોટોઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય તેની સંભાવના શોધો.

► સોડિયમના આપેલા સ્તરમાં સોડિયમના પરમાણુઓની કુલ સંખ્યા N' હોય તો આ સંખ્યાના મોલ,

$$\mu = \frac{N'}{N_A} = \frac{M}{M_0}$$

અત્રે સોડિયમ માટે મોલર પરમાણુ દળ $M_0 = 23 \text{ g/mol}$

$$\begin{aligned} \therefore N' &= \frac{MN_A}{M_0} \\ &= \frac{(V\rho)N_A}{M_0} \quad (\text{જ્યાં } V = \text{કદ, } \rho = \text{ઘનતા}) \\ &= \frac{(Axp)N_A}{M_0} \quad (\text{જ્યાં } A = \text{આડછેદનું ક્ષેત્રફળ, } x = \text{જડાઈ}) \end{aligned}$$

$$= \frac{10^{-4} \times 10^{-3} \times 0.97 \times 6.02 \times 10^{23}}{23 \times 10^{-3}}$$

$$= 0.254 \times 10^{-7+23+3}$$

$$N = 2.54 \times 10^{18} \text{ પરમાણુઓ} \quad \dots (1)$$

■ હવે, આપાત વિકિરણની તીવ્રતા,

$$I = \frac{E_n}{At} = \frac{nhf}{At} = \frac{nhc}{At\lambda}$$

⇒ એકમ સમયમાં આપેલા સ્તર પર આપાત થતાં ફોટોન્સની સંખ્યા,

$$\left(\frac{n}{t}\right) = \frac{IA\lambda}{hc}$$

$$= \frac{(100)(10^{-4})(660 \times 10^{-9})}{(6.625 \times 10^{-34}) \times (3 \times 10^8)}$$

$$= 3.321 \times 10^{16} \text{ ફોટોન્સ/સેકન્ડ} \quad \dots (2)$$

■ જો આપેલા સ્તરમાંથી એકમ સમયમાં ઉત્સર્જતા ફોટોઈલેક્ટ્રોન્સની સંખ્યા N હોય તો આ સ્તરમાંથી ફોટોઈલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જનની સંભાવના P નીચેની વ્યાખ્યા પરથી શોધી શકાય.

$$P = \frac{N}{n \times N'} = \frac{\text{ઉત્સર્જતા ફોટોઈલેક્ટ્રોન્સની કુલ સંખ્યા}}{\left(\begin{array}{c} \text{આપાત ફોટોન્સની} \\ \text{કુલ સંખ્યા} \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} \text{સોડિયમ પરમાણુઓની} \\ \text{કુલ સંખ્યા} \end{array}\right)}$$

$$\therefore P = \frac{\left(\frac{N}{t}\right)}{\left(\frac{n}{t}\right) \times N'} \quad \dots (3)$$

■ સોડિયમના આપેલા સ્તરમાં સોડિયમના પરમાણુઓની કુલ સંખ્યા N' હોય તો આ સંખ્યાના મોલ,

$$\mu = \frac{N'}{N_A} = \frac{M}{M_0}$$

અત્રે સોડિયમ માટે મોલર પરમાણુ દળ $M_0 = 23 \text{ g/mol}$

$$\therefore N' = \frac{MN_A}{M_0}$$

$$= \frac{(V\rho)N_A}{M_0} \quad (\text{જ્યાં } V = \text{કદ, } \rho = \text{ઘનતા})$$

$$= \frac{(Axp)N_A}{M_0} \quad (\text{જ્યાં } A = \text{આડછેદનું ક્ષેત્રફળ, } x = \text{જાડાઈ})$$

$$= \frac{10^{-4} \times 10^{-3} \times 0.97 \times 6.02 \times 10^{23}}{23 \times 10^{-3}}$$

$$= 0.254 \times 10^{-7+23+3}$$

$$N = 2.54 \times 10^{18} \text{ પરમાણુઓ} \quad \dots (1)$$

■ હવે, આપાત વિકિરણની તીવ્રતા,

$$I = \frac{E_n}{At} = \frac{nhf}{At} = \frac{nhc}{At\lambda}$$

⇒ એકમ સમયમાં આપેલા સ્તર પર આપાત થતાં ફોટોન્સની સંખ્યા,

$$\left(\frac{n}{t}\right) = \frac{IA\lambda}{hc}$$

$$= \frac{(100)(10^{-4})(660 \times 10^{-9})}{(6.625 \times 10^{-34}) \times (3 \times 10^8)}$$

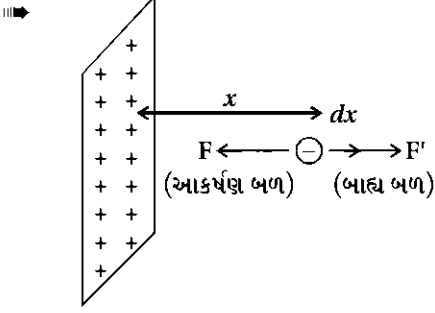
$$= 3.321 \times 10^{16} \text{ ફોટોન્સ/સેકન્ડ} \quad \dots (2)$$

■ જો આપેલા સ્તરમાંથી એકમ સમયમાં ઉત્સર્જતા ફોટોઈલેક્ટ્રોન્સની સંખ્યા N હોય તો આ સ્તરમાંથી ફોટોઈલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જનની સંભાવના P નીચેની વ્યાખ્યા પરથી શોધી શકાય.

$$P = \frac{N}{n \times N'} = \frac{\left(\frac{\text{ઉત્સર્જતા ફોટોઇલેક્ટ્રોનની કુલ સંખ્યા}}{\text{આપાત ફોટોનની કુલ સંખ્યા}} \right) \left(\frac{\text{સોડિયમ પરમાણુઓની કુલ સંખ્યા}}{\text{કુલ સંખ્યા}} \right)}$$

$$\therefore P = \frac{\left(\frac{N}{t} \right)}{\left(\frac{n}{t} \right) \times N'} \quad \dots (3)$$

3. અનંત વિસ્તારવાળી ઘન વિદ્યુતભારિત કરેલી ઘાતુની સમતલીય સપાટીથી d અંતરે મૂકેલા ઇલેક્ટ્રોન પર તે સપાટી વડે લાગતું આકર્ષણ બળ $\frac{1}{4} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{q^2}{d^2}$ (જ્યાં $q =$ ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર) હોય, તો તે ઇલેક્ટ્રોનને તે સપાટીથી 0.1 nm અંતરેથી અનંત અંતરે લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય eV માં શોધો.



- રકમમાં આપેલા સૂત્રમાં સરળતા ખાતર d ને બદલે x લખતાં,

$$F = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{q^2}{x^2}$$

- હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોનને dx જેટલું અતિસૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર, સપાટીથી દૂર તરફ આપવા માટે બાહ્ય બળ વડે કરવું પડતું કાર્ય,

$$dW = F' dx \cos 0^\circ$$

$$dW = F' dx$$

$$\therefore \int dW = \int F' dx$$

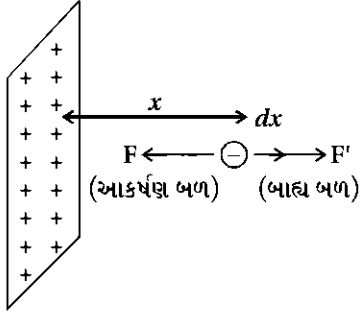
$$\therefore W = \int_d^\infty \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{q^2}{x^2} dx$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \int_d^\infty \frac{1}{x^2} dx$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left\{ -\frac{1}{x} \right\}_d^\infty$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left\{ -\frac{1}{\infty} - \left(-\frac{1}{d} \right) \right\}$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) q^2 \times \frac{1}{d}$$



રકમમાં આપેલા સૂત્રમાં સરળતા ખાતર d ને બદલે x લખતાં,

$$F = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{q^2}{x^2}$$

હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોનને dx જેટલું અતિસૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર, સપાટીથી દૂર તરફ આપવા માટે બાહ્ય બળ વડે કરવું પડતું કાર્ય,

$$dW = F' dx \cos 0^\circ$$

$$dW = F' dx$$

$$\therefore \int dW = \int F' dx$$

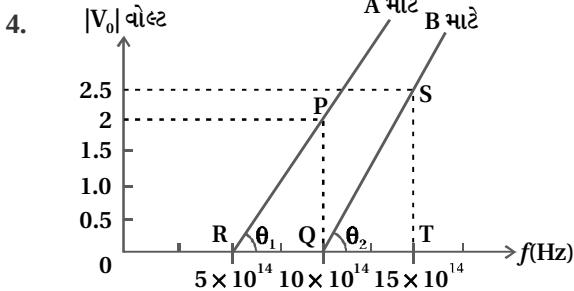
$$\therefore W = \int_d^\infty \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{q^2}{x^2} dx$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \int_d^\infty \frac{1}{x^2} dx$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left\{ -\frac{1}{x} \right\}_d^\infty$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left\{ -\frac{1}{\infty} - \left(-\frac{1}{d} \right) \right\}$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) q^2 \times \frac{1}{d}$$



એક વિદ્યાર્થીએ ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસરના પ્રાયોગિક અભ્યાસમાં બે જુદી-જુદી ધાતુઓ A અને B માટે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V_0 ના માનાંક વિરુદ્ધ આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ f માટેના આલેખો ઉપરોક્ત આકૃતિ પ્રમાણે મેળવ્યા હતા.

(i) ધાતુઓ A અને B પૈકી કઈ ધાતુનું વર્ક ફંક્શન વધારે હશે ?

(ii) બંને આલેખો પરથી પ્લાન્કના અચળાંક h માટેના મૂલ્યો મેળવી આ મૂલ્યો આઈન્સ્ટાઇનની થિયરી સાથે સુસંગત છે કે નહીં તે જણાવો.

■ (i) વર્ક ફંક્શન $\phi_0 = hf_0$ (જ્યાં f_0 = થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ)

$$\therefore \phi_0 \propto f_0 \quad \dots (1)$$

આકૃતિ પરથી,

$$f_{0A} = 5 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$f_{0B} = 10 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow f_{0B} > f_{0A}$$

$$\Rightarrow \text{સંબંધ (1) પરથી,}$$

$$\phi_{0B} > \phi_{0A}$$

(ii) $|V_0| \rightarrow f$ ના આલેખનો ઢાળ, આપણને $\left(\frac{h}{e}\right)$ નું મૂલ્ય આપે છે તેથી

A માટેના આલેખનો ઢાળ

$$\tan \theta_1 = \frac{PQ}{QR}$$

$$\therefore \frac{h}{e} = \frac{2}{5 \times 10^{14}} = 0.4 \times 10^{-14}$$

$$\therefore h = 0.4 \times 10^{-14} \times e$$

$$\therefore h = 0.4 \times 10^{-14} \times 1.6 \times 10^{-19}$$

$$\therefore h = 6.4 \times 10^{-34} \text{ Js} \quad \dots (2)$$

B માટેના આલેખનો ઢાળ

$$\tan \theta_2 = \frac{ST}{QT}$$

$$\therefore \frac{h}{e} = \frac{2.5}{5 \times 10^{14}} = 0.5 \times 10^{-14}$$

$$\therefore h = 0.5 \times 10^{-14} \times e$$

$$= 0.5 \times 10^{-14} \times 1.6 \times 10^{-19}$$

$$h = 8 \times 10^{-34} \text{ Js} \quad \dots (3)$$

આમ, A અને B માટેના આલેખો પરથી મળતાં h ના મૂલ્યો જુદા-જુદા મળે છે. તેથી ઉપરોક્ત પ્રાયોગિક અવલોકનો, આઈનસ્ટાઈનની થિયરી સાથે સુસંગત નથી.

5. 20 W નો એક બલ્બ, તેમાંથી ઉત્સર્જતા 5000 Å તરંગલંબાઈવાળા પ્રકાશ વડે, તેનાથી 2 m દૂર રાખેલી 2 eV વર્ક ફંક્શન ધરાવતી ઘાતુની સપાટીને પ્રકાશિત કરે છે. ઘાતુમાંના દરેક પરમાણુને 1.5 Å ત્રિજ્યાવાળી વર્તુળાકાર તકતી તરીકે લો.

(i) બલ્બમાંથી ફોટોનના ઉત્સર્જનનો સમય દર શોધો.

(ii) શું ઉપરોક્ત કિસ્સામાં ફોટો ઉત્સર્જન મળશે ?

(iii) વર્ક ફંક્શન જેટલી ઊર્જા એકઠી કરવામાં એક પરમાણુને લાગતો સમય t_0 શોધો.

(iv) ઉપરોક્ત પરમાણુ ઉપરોક્ત t_0 સમયમાં કેટલા ફોટોન્સ મેળવશે ?

(v) શા માટે ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર તાત્કાલિક કહેવાય છે ?

$$(i) P = \frac{E_n}{t} = \frac{nhf}{t} = \frac{nhc}{t\lambda}$$

$$\therefore \left(\frac{n}{t}\right) = \frac{P\lambda}{hc}$$

$$= \frac{(20)(5000 \times 10^{-10})}{(6.625 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}$$

$$= 5.03 \times 10^{19} \text{ ફોટોન/સેકન્ડ}$$

(ii) એક ફોટોનની ઊર્જા,

$$E_1 = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\therefore E_1 = \frac{(6.625 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{(5000 \times 10^{-10})(1.6 \times 10^{-19})} \text{ eV}$$

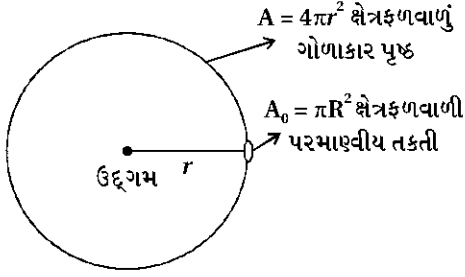
$$\therefore E_1 = 2.49 \text{ eV}$$

અત્રે $\phi_0 = 2 \text{ eV}$

$\therefore E_1 > \phi_0$

$\Rightarrow$ ફોટો ઉત્સર્જન થશે.

(iii)



વિકિરણની તીવ્રતા $I = \frac{E_0}{A_0 t_0} = \frac{P}{A}$

$\therefore t_0 = \frac{E_0 A}{P A_0}$

$\therefore t_0 = \frac{(2 \times 1.6 \times 10^{-19})(4 \times 3.14 \times (2)^2)}{(20)(3.14 \times (1.5 \times 10^{-10})^2)}$

$\therefore t_0 = 11.38 \text{ s}$

$\Rightarrow$ (i) $P = \frac{E_n}{t} = \frac{nhf}{t} = \frac{nhc}{t\lambda}$

$\therefore \left(\frac{n}{t}\right) = \frac{P\lambda}{nc}$

$= \frac{(20)(5000 \times 10^{-10})}{(6.625 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}$
 $= 5.03 \times 10^{19} \text{ ફોટોન/સેકન્ડ}$

(ii) એક ફોટોનની ઊર્જા,

$E_1 = hf = \frac{hc}{\lambda}$

$\therefore E_1 = \frac{(6.625 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{(5000 \times 10^{-10})(1.6 \times 10^{-19})} \text{ eV}$

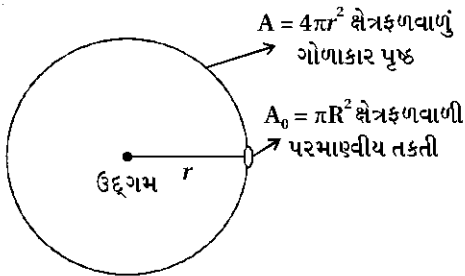
$\therefore E_1 = 2.49 \text{ eV}$

અત્રે $\phi_0 = 2 \text{ eV}$

$\therefore E_1 > \phi_0$

$\Rightarrow$ ફોટો ઉત્સર્જન થશે.

(iii)



વિકિરણની તીવ્રતા $I = \frac{E_0}{A_0 t_0} = \frac{P}{A}$

$$\therefore t_0 = \frac{E_0 A}{P A_0}$$

$$\therefore t_0 = \frac{(2 \times 1.6 \times 10^{-19})(4 \times 3.14 \times (2)^2)}{(20)(3.14 \times (1.5 \times 10^{-10})^2)}$$

$$\therefore t_0 = 11.38 \text{ s}$$